



SiC MOSFET用のセグメント化ドライブ を備えた高度な高電圧絶縁ゲート・ドライバ

GD3160

Last Updated: Mar 12, 2025

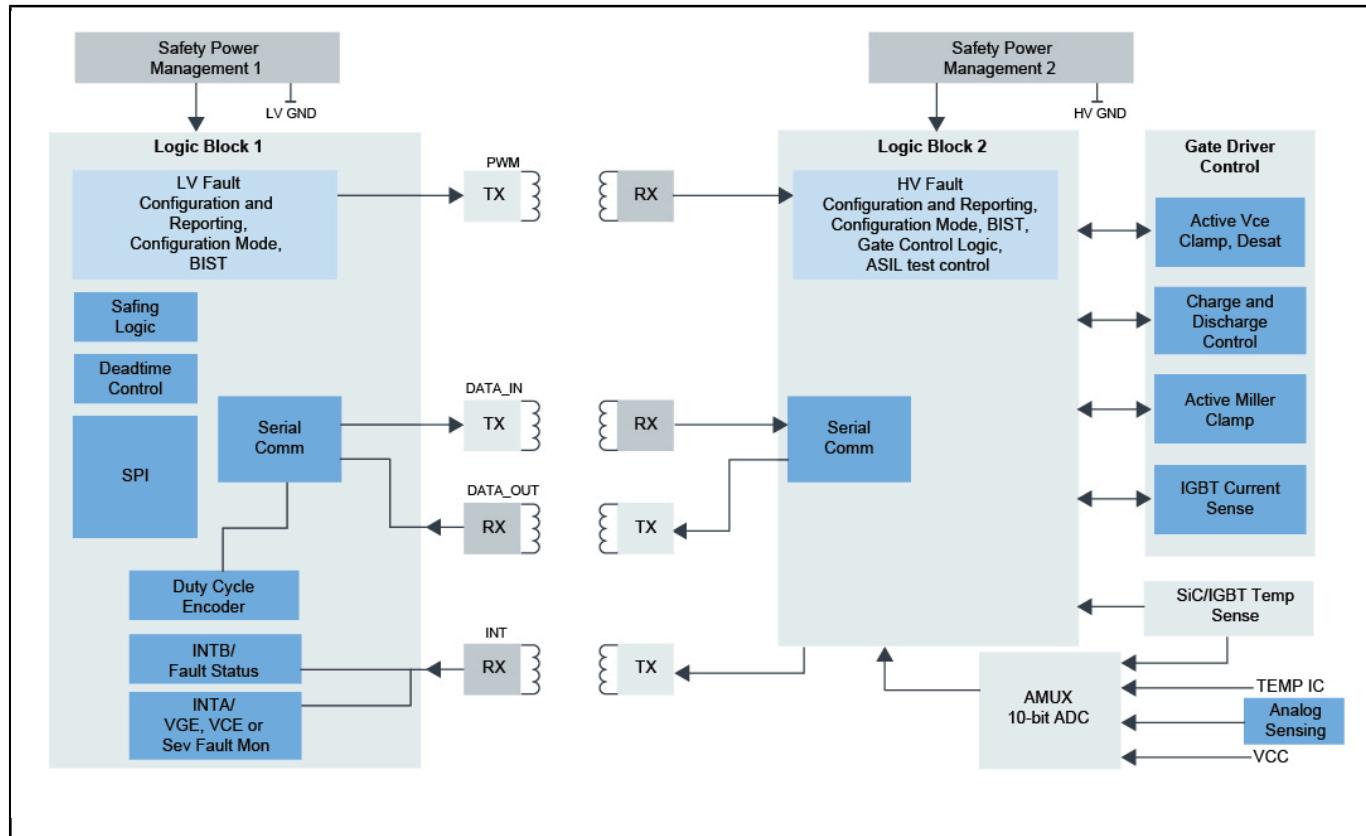
GD3160シリコンおよびイネーブルメント（ドキュメント、ソフトウェア、およびボード）は、限られたお客様のみご利用いただけます（NDAが必要です）。詳しい情報やサンプルの供給状況については、サポートまたは営業担当者にお問い合わせください。

GD3160は、炭化ケイ素 (SiC) MOSFETの駆動と保護および機能安全のために機能が強化された、改良型の高度なシングルチャネル高電圧絶縁ゲート・ドライバです。

GD3160は、SPIを介してプログラム可能な駆動、保護、およびフォルト・レポート機能を備えているため、ユーザーはほぼすべてのSiC MOSFETまたはSi IGBTパワー・スイッチの駆動および保護条件を最適化できます。

GD3160はISO 26262準拠かつ車載認定済みで、BOMコストの削減と機能安全に対応する機能を統合しており、ASIL Dに準拠した電力密度の高いxEVインバーター・ソリューションの実現をサポートします。

SiC MOSFET用のセグメント化ドライブを備えた高度な高電圧絶縁ゲート・ドライバ Block Diagram



[View additional information for SiC MOSFET用のセグメント化ドライブを備えた高度な高電圧絶縁ゲート・ドライバ.](#)

Note: The information on this document is subject to change without notice.

www.nxp.com

NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product or service names are the property of their respective owners. The related technology may be protected by any or all of patents, copyrights, designs and trade secrets. All rights reserved. © 2025 NXP B.V.